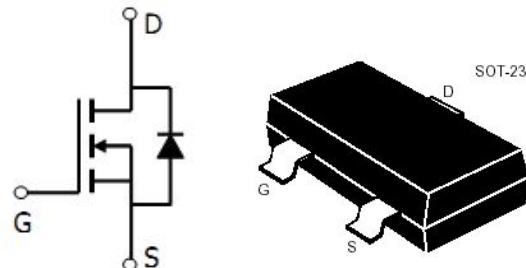


SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)



### N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs

N 沟道增强型 MOS 场效应管

### ■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	$BV_{DSS}$	200	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	$I_D$	0.4	A
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉沖	$I_{DM}$	3	A
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 $25^\circ\text{C}$	$P_D$	1300	mW
Junction 結溫	$T_J$	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature 儲存溫度	$T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

### ■DEVICE MARKING 打標

**GM2042=2042**



东莞市宇芯电子有限公司  
DONGGUAN YUSHIN ELECTRONICS CO.,LTD  
电话: 0769-89268116 传真: 0769-89268117

GM2042

## ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^\circ\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓( $I_D = 250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	BVDSS	200	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓( $I_D = 250\mu\text{A}, V_{GS} = V_{DS}$ )	$V_{GS(\text{th})}$	1	—	3	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降( $I_S=1\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	VSD	—	—	1	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=200\text{V}$ )	IDSS	—	—	1	$\mu\text{A}$
Gate Body Leakage 柵極漏電流( $V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$ )	IGSS	—	—	$\pm 100$	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻( $I_D = 0.4\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ )	$R_{DS(\text{ON})}$	—	3500	4250	$\text{m}\Omega$
Static Drain-Source On-State Resistance 静态漏源導通電阻( $I_D = 0.25\text{A}, V_{GS}=4.5\text{V}$ )	$R_{DS(\text{ON})}$	—	3600	4350	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=15\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{ISS}$	—	370	—	pF
Output Capacitance 輸出電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=15\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{OSS}$	—	23	—	pF
Turn-ON Time 开啓時間 ( $V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, R_{GEN}=25\Omega$ )	$t_{(\text{on})}$	—	11	—	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ( $V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=10\text{V}, R_{GEN}=25\Omega$ )	$t_{(\text{off})}$	—	32	—	ns

Pulse Width  $\leq 300 \mu\text{ s}$ ; Duty Cycle  $\leq 2.0\%$

## ■ TYPICAL CHARACTERISTIC CURVE

典型特性曲线

